

2025年 東京エレクトロン 共同研究公募制度募集要項

① 制度の趣旨	<p>東京エレクトロンは、「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という本理念のもと、半導体製造装置メーカーとして、半導体の技術革新への挑戦を続けています。</p> <p>その取り組みの一環として、多くの大学や研究機関との共同研究をおこない、産学連携に積極的に取り組んでいます。本制度において、当社の基本理念に通じ、半導体技術の革新や夢のある社会の発展に貢献する研究テーマを幅広く募集します。</p>
② 公募対象研究者	<p>日本国内の大学および大学院（国公立、私立問わず）、高等専門学校、その他公的研究開発機関のいずれかに所属し、該当機関において自律的な研究をおこなうことが可能な研究者を対象とします。</p> <p>営利事業を目的とした法人に所属する研究者および、研究機関に所属しない個人は対象としません。</p>
③ 研究対象領域	<p>本共同研究公募制度では、以下の研究に関するテーマを幅広く募集します。</p> <ul style="list-style-type: none">• 当社製品である半導体製造装置（成膜、コータ/デベロッパ、エッチング、洗浄、プローバ、3次元実装など）および、ディスプレイ製造装置に関する基盤技術や応用技術に関する研究、特にデバイス製造における新たなニーズに適合する研究• 上記に関連し、将来的な当社の事業領域への貢献が期待される、独創的かつ挑戦的なアカデミックな視点からのシーズ技術の研究（材料、プロセス、ロボティクス、計測、シミュレーション、制御、AI活用など含む） <p>ただし、すでに他の機関から同一課題・目的で資金提供などを受けている研究テーマは本制度の対象に含まれません。</p> <p>詳細は「別表 I 研究対象領域詳細」を参照してください。</p>
④ 共同研究期間	<p>2026年4月1日より1年を単位とし、最長3年間とします。</p> <p>1年ごとに進捗と成果をご報告いただき、翌年度の共同研究契約を更新し、締結します。</p>

⑤ 研 究 費 用	<p>共同研究の規模に応じて、次の 3 区分を設けます。 研究資金は、区分に基づいた範囲で提供します。</p> <p>① 大型研究 年間 1,500 万円以内、3 年間総額 4,500 万円を上限とする。</p> <p>② 中型研究 年間 500 万円以内、3 年間総額 1,500 万円を上限とする。</p> <p>③ 小型研究 年間 150 万円以内、3 年間総額 450 万円を上限とする。</p> <p>なお、上記費用は間接経費および消費税を含んだ合計金額です。</p> <p>間接経費は研究機関により算出方法が異なりますので、事前に貴研究機関内で算出方法をご確認ください。各費目などは、応募用紙のⅢ研究費の項を参照してください。</p>
⑥ 応 募 方 法	<p>応募用紙（題目「共同研究計画提案書」）に必要事項を記入し、PDF ファイルをメールに添付し以下宛先までお送りください。</p> <p>メールタイトル 【2025 年 東京エレクトロン 共同研究公募提案書：研究機関名・氏名】 （研究機関名と氏名をお書き添えてください。）</p> <p>宛先 telstdkyokenkoubo@tel.com</p> <p>受付開始 2025 年 7 月 28 日（月） 締め切り 2025 年 8 月 12 日（火）必着</p>
⑦ 審 査 方 法	<p><u>1 次審査</u></p> <p>提出された「共同研究計画提案書」に基づき、書類審査をおこないます。1 次審査では、原則として秘密保持契約は締結しません。 「共同研究計画提案書」は、公知の事実として当社に開示できると判断された情報に基づき作成してください。</p> <p><u>最終審査</u></p> <p>1 次審査を通過した場合は、研究計画の詳細について最終審査をおこないます。最終審査にあたり、提案者の希望があれば、秘密保持契約を締結の上、当社担当社員と研究内容、実施計画、研究資金の妥当性などについて協議をおこなう場合があります。</p> <p>最終審査では、提案者による共同研究計画のプレゼンテーションおよび質疑応答をおこないます。</p> <p>最終審査を通過し、共同研究契約の締結をもって正式採択とします。</p>

<p>⑧ 審 査 基 準</p>	<p>1 次審査、最終審査にあたっては、以下の点に重点を置き審査をおこないます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 当社の事業領域である半導体製造装置技術における技術ニーズと関連性があること。 ▶ 将来的な当社の事業領域への貢献が期待されるシーズ技術に関する研究であること。 ▶ 共同研究計画提案書の内容および研究計画の妥当性や将来性、継続性の観点で優れていること。
<p>⑨ 提 出 書 類 の 取 り 扱 い</p>	<p>提出された共同研究計画提案書は、当社での審査選考のみに使用します。なお、審査の結果に依らず共同研究計画提案書の返却はおこないません。共同研究計画提案書は、秘密情報として適切に管理します。</p>
<p>⑩ 審 査 結 果 の 通 知</p>	<p>審査結果は、結果の如何に関わらず 1 次審査、最終審査ともに、提案者の電子メールアドレス宛に連絡します。</p>
<p>⑪ 共 同 研 究 契 約 書 の 締 結</p>	<p>共同研究契約書や提案者の希望により締結する秘密保持契約書は、提案者が所属する組織と当社の間で締結します。</p> <p>共同研究契約の契約期間は各研究年度を基準とし、単年度の契約とします。</p> <p>共同研究契約書の雛形は、両者協議の上、決定します。</p> <p>ただし、学会発表など対外的に共同研究成果を公表する際に、発表内容について当社への通知を公表 30 日前に、最終版の原稿提出を公表 3 週間前におこなっていただくことを盛り込ませていただきます。(公表とは貴研究機関 – 当社外に情報が開示される事を意味し、学会での発表だけでなく、事前の原稿投稿などすべての情報開示を含みます。)</p>

<p>⑫ 共同研究開始までのプロセス</p>	<p>共同研究開始までのプロセスは以下の予定です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 応募期間 2025年7月28日（月）から2025年8月12日（火）まで ➤ 1次審査結果の通知 2025年10月17日（金）まで 1次審査通過を通過した提案者の方は、最終審査に向けた詳細な研究計画の作成と提出をお願いします。 ➤ 最終審査 2025年12月上旬から中旬に実施予定（日時未定） 最終審査では、提案者による共同研究計画のプレゼンテーションおよび、質疑応答をおこないます。 ➤ 最終審査結果の通知 2025年12月19日（金）まで 最終審査通過後、共同研究契約の締結手続きを開始します。 ➤ 共同研究契約の締結日 2026年4月1日（同日に遡及して契約可能） ➤ 共同研究の開始日 2026年4月1日
<p>⑬ 共同研究成果の帰属</p>	<p>共同研究の成果として得られた知的財産権の取り扱い、取得した設備の取り扱い、成果物の取り扱いなどについては、両者協議の上、「共同研究契約書」において文書化します。</p>
<p>⑭ 共同研究進捗状況の報告と共同研究成果報告書の作成</p>	<p>共同研究の実施にあたっては、適切な頻度での研究進捗の報告および、年度ごとに期末報告書の提出、最終年度においては共同研究成果報告書の提出をお願いします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 進捗報告会（必要に応じて随時開催） ➤ 中間報告会（10月頃開催） ➤ 継続審査会（1月頃開催） 翌年度の共同研究継続の審査をおこないます。 ➤ 期末報告会および期末報告書提出（3月～5月） 最終年度においては共同研究成果報告会、共同研究成果報告書

⑮ 個人情報の取り扱い	<p>応募時にご提供いただいた個人情報は、本制度の業務に必要な範囲に限定して、適切に利用します。また、本制度を実施する目的で東京エレクトロングループ各社において共同利用させていただきます。</p> <p>当社における個人情報の取り扱いについては、以下 URL の Link 先をご参照ください。</p> <p>https://www.tel.co.jp/privacy/</p>
⑯ お問い合わせ先	<p>本制度に関するご質問は下記宛先までメールにてお願いします。</p> <p>メールタイトル：【共同研究公募制度質問：研究機関名・氏名】 (研究機関名と氏名をお書き添えください。)</p> <p>宛先メールアドレス：telstdkyokenkoubo@tel.com</p>

※募集要項内における「当社」とは、東京エレクトロン株式会社とその関連会社を含みます

別表 I 研究対象領域詳細

大分類	中分類	研究・技術領域
理工学全般	薄膜、表面界面物性	ナノ・原子スケールの材料構造制御技術と物性反応制御技術、エッチング・成膜・表面改質技術、自己組織化材料技術、表面吸着・脱離制御技術
	構造・機能材料	半導体デバイス材料の成膜技術（強誘電体、高誘電体、低誘電体、低抵抗配線材、バリア膜、熱伝導率が高い絶縁膜、2次元材料、選択成長膜、マスク材など）、新構造による新機能発現
	プラズマ応用技術	プラズマ発生源とプラズマ制御技術、プラズマ状態の計測・診断技術、中性粒子・負イオン応用のプロセス技術
	シミュレーション工学	空間場（熱流体・電磁場・希薄気体・プラズマなど）の定常・非定常・過渡応答シミュレーション技術
	分析・計測技術	ナノ・原子スケールの表面および界面の分析・計測技術、半導体デバイス材料の構造・物性分析・計測技術
化学	化学プロセス	洗浄・酸化・還元プロセス技術、触媒応用プロセス技術、気液固相の反応プロセス技術、光応用プロセス技術
	新材料	有機・無機複合材料による新機能技術、プリカーサ設計・供給技術、フォトレジスト材料、塗布型絶縁膜材料、エッチングケミカル、環境規制代替材料

大分類	中分類	研究・技術領域
工学全般	生産技術	超精密加工、積層造形、接合、表面処理などの製造加工技術、基板搬送技術（ロボット、アーム、ステージ周囲の高速精密搬送など）、熱伝達、希薄ガスなど流体制御技術、ガラス基板を扱う技術、装置自動メンテナンス技術
	新材料	機能性複合材料、高耐熱性材料、高耐食性材料、高耐プラズマ性材料、低ガス放出材料などの構造化・成形技術、装置構成材料の軽量化技術、表面コーティングによる汚染・パーティクル抑制技術
	センサー・制御技術	各種センシング技術、広帯域データ通信制御技術、基板・処理室内環境制御技術（温度、圧力、電位など）、高速温度制御
	コンピュータ・知能情報処理	高速・大容量画像処理技術、分散データ処理技術、装置生産性や開発業務効率を向上させる AI（機械学習、協調学習、深層学習）、マテリアルズ・インフォマティクス（MI）、DX 技術、量子コンピュータを用いた科学計算技術
環境工学 （ 持続可能 低炭素社会 実現 ）	創エネルギー	革新的高効率エネルギー変換・利用技術（熱エネルギーなど）、革新的断熱、伝熱制御技術
	省エネルギー	電力／動力変換システムの省エネ・高効率化関連技術、省電力データ通信・情報処理技術
	カーボンニュートラル	高効率、低エネルギーでの温室効果ガス分離・吸着技術